(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: 51/40

H01L 51/20.

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003776

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];

Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen

- 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO **FUNCTIONAL LAYERS** 

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC  $\,\,^7$   $\,\,$  H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6, line 50 -/	1-4,7

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents:  'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  'E' earlier document but published on or after the International filing date  'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-
On document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means On document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.  *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search  15 July 2004	Date of mailing of the International search report  22/07/2004
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Königstein, C

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interptional Application No PCT/DE 03/03776

	PCT/DE 03/03776					
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Retevant to claim No.				
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Helevall to claim No.				
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	1-4				
<b>Y</b>	the whole document	8				
Y	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document	8				
A	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document					
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document					
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6	1-8				

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

KLASSIFIZIERUNG DEŞ ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

_		WESENTL	IOL	ALICEO	CLICALE	INTER	ACEN
C.	ALS	WESENII	.IGN	ANGES	EMENE	ONIERL	AGEN

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Seiten 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 das ganze Dokument	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 50 -/	1-4,7

d der Fortsetzung von Feld C zu
1

Slehe Anhang Patentfamilie X

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* äiteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedaturn veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- verörlenmenung, wer sich auf eine minibilitäte Unehbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- \*T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigikalt beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 22/07/2004 15. Juli 2004 Bevoltmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Königstein, C Fax: (+31-70) 340-3016

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03776

PC1/DE 03/03/76					
	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.			
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	1-4			
Υ	das ganze Dokument	8			
Y	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8			
A	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument				
A	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument				
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6	1-8			

#### HATELMAN IONALLI MEGILIOI LINCHEMPINIOI

Angaben zu Veröffentlik

. die zur selben Patentfamilie gehören

In tionales Aktenzeichen	
PCT/DE 03/03776	

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003